文章编号: 0258-7025(2002)Supplement-0555-03

# 激光微区烧蚀典型工程材料的机理研究

曾晓雁<sup>1</sup> B. Ozygus<sup>2</sup> H. Weber<sup>2</sup>

华中科技大学激光技术国家重点实验室,激光加工国家工程研究中心,武汉 430074

Optical Institute, Department of Physics, Technical University, BerlinBerlin, Germany

摘要 研究了 LD 抽运 YAG 激光烧蚀 W, Ta, Nb, Fe 等金属和单晶硅、金刚石等材料的速率与机理,结果表明材料的熔点、沸点、导热性、晶体结构等参数对激光烧蚀速率影响很大。对激光烧蚀的物理模型进行了初步分析。

关键词 YAG激光, 微区烧蚀, 烧蚀速率 中图分类号 TN249 文献标识码 A

## Parameters and Mechanisms of Laser Ablation Typical Engineering Materials

ZENG Xiao-yan<sup>1</sup> B. Ozygus<sup>2</sup> H. Weber<sup>2</sup>

National Key Laboratory of Laser Technology, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074 <sup>2</sup> Optical Institute, Department of Physics, Technical University Berlin, Berlin, Germany

**Abstract** The ablation rates and mechanisms of typical engineering materials such as Ni, W, Ta, Cu, Si and diamond by diode pumped YAG laser were analyzed. It was found that a lot of factors such as the melting point, evaporation point, thermal conductivity and crystal structure have a big effect on the abalation rates. In almost all the cases, the materials are heated up to melting point and the evaporation is the main mechanism for laser ablation.

Key words YAG laser, laser ablation, ablation rates

# 1 引 言

LD 抽运 YAG 激光器因为体积小、抽运效率 高、光束质量好,在激光加工领域特别是精密、微细 加工领域中正得到越来越广泛的应用。例如,采用 LD 抽运 YAG 激光器对许多种金属材料、陶瓷材 料、高分子材料进行切割、焊接、打标等加工,已被成 功应用于工业生产中。激光加工技术的重要特点之 一是可以完成超硬、超脆或者超软工程材料的加工, 有关的工程技术人员也进行了许多的前期研究与开 发工作,但迄今为止仍然缺乏有关激光加工许多典 型工程材料机理研究的基础数据。本文正是针对这 一问题进行了一些研究工作。

2 实验设备与方法

激光加工实验是在柏林工业大学光学研究所 Weber 教授的研究室进行的。所使用的激光器为 LD 抽运 YAG 激光器,输出功率分别为 90 mW, 230 mW 和 360 mW,激光重复频率为 25000 Hz, 脉宽为 5 ns,光斑直径约为 15 μm。用于加工的材 料包括典型金属材料 Cu,W,Ta,Nb,Ti,In,Al,Cu-Zn 合金等和典型非金属材料如单晶硅、金刚石等。 激光烧蚀区域的面积为 400 μm×125 μm。

实验方案分为两类,一是相同激光辐照时间下, 不同激光功率对各种材料烧蚀速率的影响规律;二 是相同激光功率下,激光烧蚀速率与时间的关系。 烧蚀实验完成后,用带有刻度尺的光学显微镜在高 放大倍数下测试烧蚀前后平面与底面的聚焦点尺寸 变化来判定激光烧蚀的平均深度(测定精度为1 μm)。采用 Hitachi 2000 的扫描电子显微镜及能谱 分析仪对烧蚀表面进行成分与形貌分析。

# 3 结果与讨论

#### 3.1 激光辐照时间对烧蚀深度的影响规律

表1给出了激光烧蚀不同材料时烧蚀时间与烧 蚀深度的关系,该表还同时列出了被加工材料的熔 中

光

点和沸点。根据表1绘出的曲线见图1。根据表1 和图1,不难得出如下结论:

 材料的熔点与沸点对激光烧蚀速度影响很大。一般而言,随着材料熔点与沸点的提高,激光烧 蚀速率降低;

2) 材料的热导率对激光烧蚀的速率影响很大。 例如,Cu的熔点和沸点虽然远远低于 Ni,但其激光 烧蚀速率则远低于后者,主要原因就在于前者的热 导率比后者高得多;

3) 材料的化学稳定性对激光烧蚀速率影响很大。Ti 和 Nb 的激光烧蚀速率低于 Ta 和 W, 可能的原因就在于前者化学活性比较大,在空气中进行激光烧蚀时容易在表面生成氧化物,导致激光烧蚀的能量阈值提高。

Pd

Fe

W

Ti

Nb

Cu

Si

In

Ni

Al

Ta

Cu-Zi

	I Itelati	mismp oc	meen nuse	inradiati	on this is		tion depth	TOT UITTE	ent mater		
depth/µm materials	In	Al	Cu	Si	Ni	Fe	Pd	Ti	Nb	Ta	W
10	6	6	4.5	10	1	1	6	1	2	2	
20	12	12	8	17	2	2.5	11	3	8	4	2
40	42	23	14	29	4	5	15	4	10	6	4
80	>100	49	21	69	10	11	26	7	12	10	11
160	hestori	81	41	210	20	19	48	12	19	18	24
320	0 -	160	76	321	50	40	66	30	28	48	36
$T_m(\mathcal{C})$	156	660	1083	1410	1453	1535	1552	1660	2468	2996	3410
$T_v(\mathcal{C})$	2000	2467	2567	2335	2732	2750	2927	3287	4927	5425	5560

表1 不同材料的激光辐照时间与烧蚀深度的关系



#### 图1 不同材料表面激光烧蚀深度与时间的关系

Fig.1 Relationship between laser ablation depth versus time at different material surface

#### 表 2 激光能量密度对烧蚀深度的影响

Table 2 Influence laser power density on ablation depth

current/A depth/µm		Laser irradiation times /s								
materials		10	20	40	80	160	320			
Al	16A	6	12	23	49	81	96			
	18A	10	24	55	106	147	290			
Pd	16A	6	11	15	26	48	66			
	18A	6	10	22	42	62	Pass through			
w	16A	1	2	4	11	24	36			
	18A	4.5	9	19	36	72	161			
Ta	16A	2	4	6	10	18	48			
	18A	4	6.5	13	20	38	67			

### 3.2 激光能量密度对烧蚀深度的影响规律

表2给出了激光能量密度对材料烧蚀深度的影响。由该表可见,对所有材料,随着激光能量密度的 增加,激光烧蚀深度也相应增加。然而,激光烧蚀时 不同材料的烧蚀速率增加幅度是不同的。例如,当 激光电源电流由 16 A 增加到 18 A 时, Al 的烧蚀速 率增加近两倍, 而 W 的烧蚀速率增加几乎 4 倍。

556

#### Supplement

### 3.3 不同材料激光烧蚀的 SEM 形貌分析

图 2 给出了几种典型材料激光烧蚀的形貌,可 见对不同的材料而言,激光烧蚀后的形貌相差很大。 在相同倍率的显微镜下观察,铜表面激光烧蚀后结 晶形态十分明显,单晶硅和钨材料则在粗糙的表面 上覆盖有微细的颗粒,金刚石表面则非常平整光滑。 一般而言,激光烧蚀机理有两种,一种是热蒸发



(a) red copper



(c) W

机理,即激光束将材料表面瞬间蒸发到熔点与沸点 之上,成为蒸气而逸出到空中。另一种是冷加工机 理,主要是利用短波长激光的直接"切断"作用,使被 加工的固体材料以原子态或者分子态的方式逸出到 空中。从本实验所采用的激光工艺参数范围和激光 烧蚀后试样的表面形貌来看,上述材料的烧蚀机理 主要是热蒸发过程。





(d) diamond

图 2 不同材料激光烧蚀后的表面形貌. (a) 紫铜表面;(b) 单晶硅表面; (c) 钨表面; (d) 金刚石表面 Fig. 2 Surface morphology of laser ablation for different material. (a) red copper; (b) Si; (c) W; (d) diamond